

კრისტალების ზრდის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ

ნინო ხატიაშვილი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
თბილისი, საქართველო, ninakhatia@gmail.com

განხილულია პოლიგონალური კვების მქონე ხელოვნური კრისტალების ზრდა მუდმივი ტემპერატურისა და წნევის პირობებში. ზრდის პროცესი აღიწერება სამგანზომილებიანი რეაქცია-დიფუზიის განტოლებით შესაბამისი საწყისი-სასაზღვრო პირობებით [1,2,3]. ცვლადთა განცალების მეთოდით ამოცანა დაყვანილია ორგანზომილებიან ამოცანაზე, რომლის ეფექტური ამოხსნები მიიღება კონფორმულ ასახვათა მეთოდით.

ლიტერატურა

1. Khatiashvili N., O.Komurjishvili O., A.Papukashvili A., Shanidze R., Akhobadze V., Makatsaria T., Tevdoradze M., On Some Mathematical Models of Growth of Solid Crystals and Nanowires, Bulletin of TICMI, Tbilisi, 2013, Vol.17, N 1, pp.28-48.
2. Akhobadze V., Gamrekeli D., Khatiashvili N., Pirumova ,K On Some Pathologies Connected with the Crystallization Process at the Human body (Gallstones Formation.), Rep. Enlarged Sess. Sem. I. Vekua Inst. Appl. Math., Tbilisi, 2015, Vol. 29, pp. 1-4.
3. Mersmann A., Chrystallization Technology Handbook. CRC, 2001.